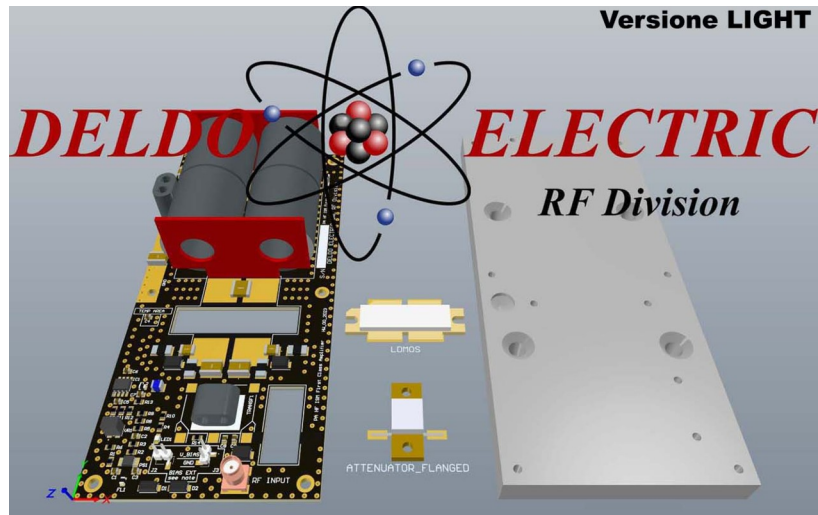
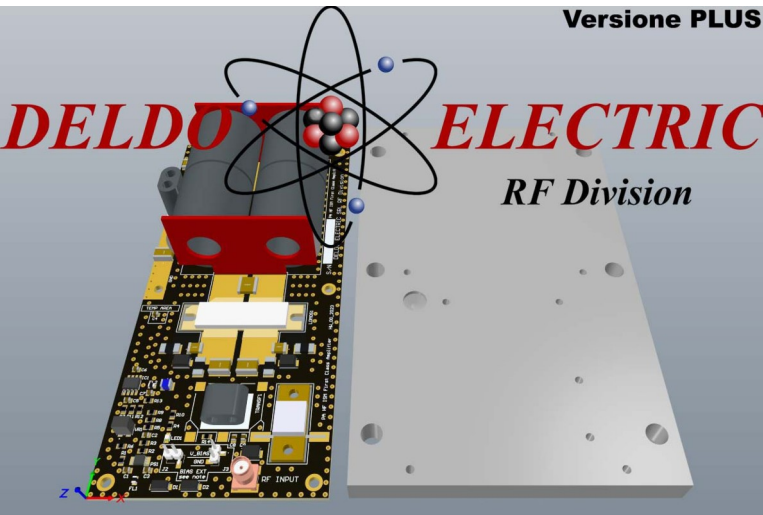


Brochure PA HF+6
Powered by NEW LDMOS AMPLEON ART1K6FH



Questo PA nasce dall'esperienza ultra ventennale nel settore RF e dalla DERIVAZIONE PROFESSIONALE di un nostro prodotto per ambienti ISM.

E' stato concepito per soddisfare le più recenti esigenze del mercato per i settori:

- Ambienti ISM
- Ambienti MILITARI
- Misure EMC
- Radio comunicazione HF e VHF (da 1.8MHz a 50MHz)

L'utilizzo delle più recenti tecnologie di amplificazione a stato solido, oltre all'uso di specifici software, ci hanno permesso di raggiungere importanti obiettivi, tra i quali:

- Riduzione degli ingombri
- Riduzione dei costi
- Incremento dei benefici tra i costi e i ricavi
- Incremento dell'efficienza energetica
- Incremento delle prestazioni

Il nuovo PA HF+6 è disponibile in due versioni, con prezzi differenti:

- Versione con opzione PLUS** (1440mm² 96mm X 150mm)
- Versione con opzione LIGHT** (1050mm² 70mm X 150mm)

Il "Traslatore e spalmatore" termico sottostante il PCB è realizzato come STANDARD in ALLUMINIO oppure OPZIONALE in RAME.

L'innovativo circuito di BIAS, unico al mondo nel suo genere, permette il controllo perfetto della IDQ con variazione per frazione di grado, inseguendo alla perfezione l'andamento termico del dispositivo LDMOS, permettendo tra l'altro, la possibilità di lavoro del PA in classe superiore.

Il nuovo PA HF+6 prevede l'alimentazione del circuito di BIAS direttamente da quella principale, oppure può essere alimentato separatamente.

Sono presenti dei selettori per scegliere la configurazione necessaria.

La tensione di BIAS sui GATE varia da 1.5V a 3V ed è compatibile con tanti dispositivi appartenenti alle classi:

- ART
- BLF
- MRF
- MRFE
- MRFX e altri.

Il sensore è posizionato nel lato SOTTO (BOTTOM) del PCB (**foto 1**).

Questa configurazione, oltre a costituire un'ulteriore schermatura da RF, elimina le influenze provenienti da eventuali flussi d'aria di superficie.

foto 1



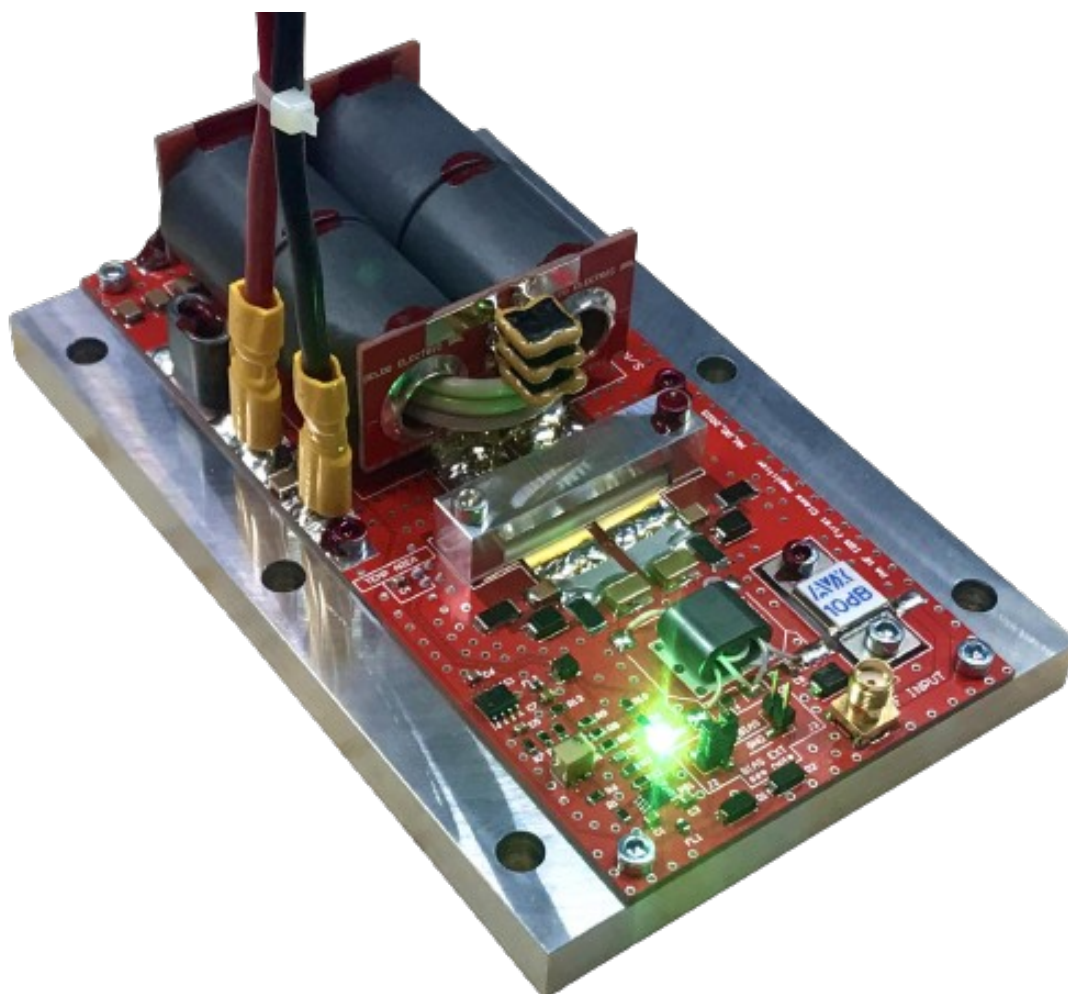
Sono stati adottati diversi criteri per la PROTEZIONE del dispositivo LDMOS, rendendolo ancora più robusto e affidabile, anche se a discapito di qualche Watt d'uscita.

Nel circuito d'ingresso RF troviamo un ATTENUATORE con potenza di 150W del tipo a flangia e dei diodi specifici del tipo TVS, sistemi che ne aumentano la

La progettazione accurata, la qualità dei componenti e altri fattori, hanno permesso anche di eliminare i fenomeni di auto oscillazione.

I processi di sviluppo per studi di fattibilità, simulazioni e modellazioni, fin dall'inizio hanno richiesto specifici software e banchi di test allestiti appositamente.

Tutti gli obiettivi prefissati, basati su target qualitativi ai massimi livelli sono stati raggiunti. Tutto il work process è stato realizzato internamente presso il laboratorio DELDO ELECTRIC SRL



DELDO ELECTRIC SRL
Strada Statale 150, Pianura Vomano 34A
64024 Notaresco (TE) ITALIA
<https://www.deldoelectric.com/>
P. IVA: IT02007600675